



理工学専攻電気電子工学コース大学院生が 国際ダイヤモンドデバイスワークショップで最優秀講演賞を受賞

【概要】

理工学専攻電気電子工学コース修士課程2年(当時)の高谷 亮太 さんが、2022年2月21~22日に本学でオンライン開催された第1回国際ダイヤモンドデバイスワークショップ(1st International Diamond Device Workshop)にて最優秀講演賞(Best Presentation Award)を受賞しました。

【本文】

国際ダイヤモンドデバイスワークショップは、海外や日本の大学、企業の研究者や学生が、次世代パワー半導体として期待されるダイヤモンド半導体デバイスの研究成果を発表し議論する場として今年から毎年開催されることになった国際会議です。2日間にわたり22件のオンライン発表がありましたが、そのうちの優秀な口頭発表者5名に最優秀講演賞が授与されました。

理工学専攻電気電子工学コース修士課程2年(当時)の高谷 亮太 さん(指導教員:嘉数 誠 教授)は「サファイア基板上にヘテロエピタキシャル成長した高品質ダイヤモンド膜の成長— MgO 基板との比較」(Growth of high-quality inch-diameter heteroepitaxial diamond layers on sapphire substrates in comparison to MgO substrates)の講演題目で、大口径で最高品質のダイヤモンド結晶が、ヘテロエピタキシャル成長する過程を原子間力顕微鏡等で明らかにした成果を英語で口頭発表し、研究レベルの高さと英語でのわかりやすい発表、適切な質疑応答が非常に高く評価されました。嘉数教授を核とする研究グループによる本分野の益々の発展が期待されます。

○最優秀講演賞(Best Presentation Award)

理工学専攻電気電子工学コース修士課程2年(当時)

高谷 亮太 さん(指導教員:嘉数 誠 教授)

題目:「サファイア基板上にヘテロエピタキシャル成長した高品質ダイヤモンド膜の成長— MgO 基板との比較」

(Growth of high-quality inch-diameter heteroepitaxial diamond layers on sapphire substrates in comparison to MgO substrates)

発表者:高谷 亮太, 金 聖祐, 嘉数 誠

(Ryota Takaya, Seong-Woo Kim, Makoto Kasu)



受賞した高谷 亮太さんの賞状